


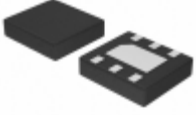
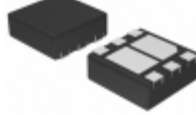
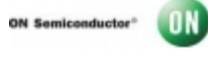

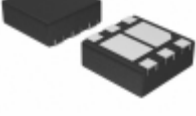


	<h2>NTLGD3502NT1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTLGD3502NT1G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 4.3A/3.6A 6DFN</p> <p>Datenblätter:  NTLGD3502NT1G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 602 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTLGD3502NT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 4.3A/3.6A 6DFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	602 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.74W
Verpackung / Gehäuse	6-VDFN Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	6-DFN (3x3)
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.3A, 3.6A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 4.3A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	480pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTLGD3502NT1G ist neu im Original. Suche NTLGD3502NT1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTLGD3502NT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTLGD3502NT1G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTLJD2105LTBG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 8V 2.5A 6-WDFN</p>	 <p>NTLGF3501NT2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 2.8A 6-DFN</p>	 <p>NTLJD2104PTBG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 12V 2.4A 6WDFN</p>	 <p>NTL4502NT1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 4N-CH 24V 11.4A 16PIN</p>
 <p>NTLJ3113PT1G ON NTLJ3113PT1G ON</p>	 <p>NTLJD2104PTAG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 12V 2.4A 6WDFN</p>	 <p>NTLGF3402PT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.3A 6-DFN</p>	 <p>NTLGF3402PT2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 2.3A 6-DFN</p>

heiße Teile

Mehr

AMIS30621C6217RG	BZX84-C24	C1608X8R2A103K080AA	C5750X5R2J224K230KA	CY7C178-9JC
ERF8-050-05.0-L-DV-TR	LT1790BIS6-3#TRMPBF	MCP9804-E/MS	MCR100JZHJLR56	NTLGD3502NT2G
NTLJ3113PT1G	NTLJD2105LTBG	NTLJD3115PT1G	NTLJD3115PTAG	NTLJD3119CT1G
NTLJD3119CTAG	NTLJD3119CTBG	NTLJD4116NT1G	NTLJF3117PT1G	NTLJF4156NT1G
NTLJF4156NTAG	NTLJS2103P	NTLJS2103PTAG	NTLJS2103PTBG	NTLJS3113P
NTLJS3113PT1G	NTLJS3113PTAG	NTLJS3A18PZTWG	NTLJS4114NT1G	NTLJS4114NTAG
NTLLD4901NF	NTLLD4901NFTWG	NTLTD7900NR2G	NTLTD7900ZR2	NTLTD7900ZR2G
NTLUD3A260PZTAG	NTLUD3A50PZTAG	NTLUF4189NZTAG	NTLUS3A18PZTAG	NTLUS3A40PZTAG
NTLUS3A40PZTBG	NTLUS3A90PZTAG	NTLUS4930NTAG	NTS4001NT1G	PAH50S48-5/V
SKT450/18C	SMT05E-12W3V3	TCA62746AFG-F	VUO62-06NO7	ZXMN4A06GQTA

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited